



## 2026年度 事業戦略説明会

半導体事業本部

2026年5月27日

半導体事業本部の宝泉です。  
2026年度の事業戦略についてご説明します。よろしくお願いします。

01	事業概要	P. 3
02	2025年度の振り返り	P. 6
03	2026年度経営計画	P. 8
	市場動向	P. 9
	事業方針・事業計画・重点施策	P.10
	設備投資・研究開発	P.20

## 01 事業概要

## 事業概要

### 車の電動化、パワーエレクトロニクス機器の小型化、省エネ、CO2削減などに貢献



まず、事業の概要からご説明いたします。当社の半導体事業では、自動車の電動化やパワーエレクトロニクス機器の小型化・省エネ化に貢献する「パワー半導体」を扱っております。市場としては、大きく「電装分野向け」と「産業分野向け」の2つに分かれています。

左側の電装分野向けは、電動車の駆動用インバータなどに使われる電装モジュールと、エンジン制御やブレーキ制御などに使われる電装ディスクリートで構成されています。

右側の産業分野向けは、モータードライブや再生可能エネルギー等に使われる産業モジュール、そしてテレビやプリンターなどに使われる産業ディスクリート、および感光体といった製品群です。

昨年度の売上構成比は、約半分为電装向け、もう半分为産業向けとなっております。

## IGBTモジュール世界シェア第3位

- IGBTモジュール市場で世界トップクラスのポジション
- 業界初RC-IGBTを市場展開、国内外の電動車メーカーに採用
- 豊富な市場実績と高信頼性技術の保有

## 先端チップと高密度実装技術

- 第7、8世代IGBTや第3世代SiC-MOSFETなど、業界トップクラスの低損失性能
- 低損失チップと高密度実装技術を組み合わせた業界最小のモジュール製品
- 特性変動が少なく装置の最適設計が可能

## グローバルな顧客サポート

- 国内外のマルチ生産拠点、販売・デザインセンター

## 顧客装置・製品への貢献

- 省エネ性能・出力拡大
- 小型化・省スペース化
- 顧客要求品質の確保
- 設計マージンの最適化

当事業の強みは、大きく3点ございます。

1点目は、IGBTモジュールで世界シェア3位という、世界トップクラスのポジションにいます。また、業界で初めてRC-IGBTを市場展開し、国内外の電動車メーカーに広くご採用いただいているほか、高い信頼性を保有している点も強みです。

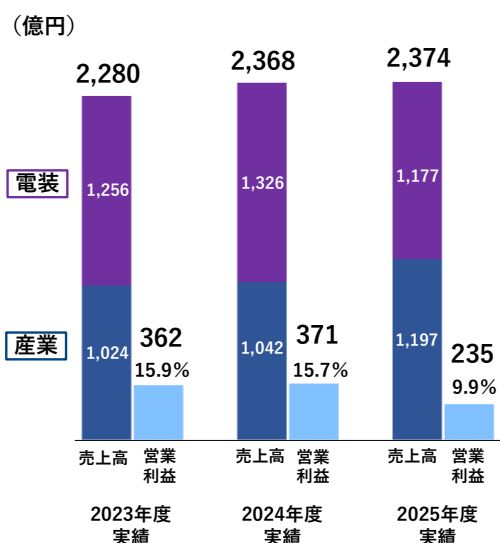
2点目は、先端チップと高密度実装技術です。現在、第7世代に続き第8世代のIGBT、そして第3世代のSiCなどをリリースする予定ですが、これらはトップクラスの低損失性能を誇ります。このチップと高密度実装技術を組み合わせることで、世界最小クラスのモジュール製品を実現しています。また、製品の特性変動が非常に少ないため、お客様側での装置の最適設計が可能であるという特徴も持っています。

3点目は、グローバルな顧客サポート体制です。生産拠点やデザインセンターを国内外に多数保有しており、これらを通じて、お客様の装置や製品の省エネ化、小型化、高品質化に貢献しております。

## 02 2025年度の振り返り

# 2025年度の振り返り

## サブセグメント別売上高・営業利益



## 主な成果

- ・ SiC前工程の増産投資による売上拡大  
生産能力：前年比 2.5倍（富士電機津軽セミコンダクタ）  
売上高：前年比 約2倍
- ・ 新製品 量産開始  
再エネ向け大容量IGBTモジュール（1.7kV/2.3kV）  
電動車向け第3世代SiCチップ、小型RC-IGBTモジュール
- ・ 第8世代IGBTモジュール サンプル展開開始

## 課題

- ・ 電装分野の売上拡大  
新規スペックイン、新規顧客開拓の推進
- ・ 収益力の向上
- ・ 競争力のある新製品の開発

2025年度の振り返りとなります。

昨年度の業績は、売上高が2,374億円、営業利益が235億円という結果でした。

主な成果としては、まずSiCの前工程における増産投資による売上拡大が挙げられます。昨年度は生産能力を前年比で2.5倍まで引き上げ、その結果、SiCの売上高は前年比で2倍に拡大いたしました。






2つ目は、新製品の量産開始です。再エネ向けの大容量IGBT、電動車向けの第3世代SiC、あるいは小型のRC-IGBTモジュールなどの量産を開始したほか、第8世代IGBTモジュールのサンプル展開も昨年から開始しております。

一方で課題としては、電装分野の売上がやや停滞しているため、ここを拡大していく必要があります。そのため、新規案件の獲得（スペックイン）や、新規顧客の開拓を現在推進しております。2点目は収益力のさらなる向上、3点目は競争力のある新製品の開発です。

## 03 2026年度 経営計画



- 産業：モータードライブ向けで需要が拡大
- 電装：電動車全体で継続伸長する見込み

事業分野	当社対象市場動向（2026年度）		2025 → 2026年度
産業	モーター ドライブ※1	AI向け半導体好調により半導体製造装置や産業ロボット向けが需要増。NC工作機械は自動化・効率化の需要が継続	
	再エネ	太陽光発電は鈍化するが、風力発電及び蓄電池(ESS※2)向けは堅調見込み	
	民生	省エネ規制によるルームエアコンの買替え需要、企業のDX推進及び5G普及による通信機器の需要増で緩やかに伸長	
電装	電動車	電気自動車(BEV)、ハイブリッド車(HEV/PHEV)共に増加が継続し、2桁成長の見込み	
	エンジン車	減少傾向は継続	

※1 モータードライブ：インバータ・サーボ、NC工作機械、産業ロボット等  
 ※2 ESS: Energy Storage System

ここからは、2026年度の経営計画についてご説明いたします。  
 まず市場動向ですが、産業分野におきましては、モータードライブで半導体製造装置や産業ロボットなどの需要が増えている傾向にあります。また、NC工作機械についても堅調に需要が増加している状況です。

再エネ関係では、太陽光発電で中国の補助金が終了した影響で鈍化するものの、風力発電および蓄電池関係も堅調に推移する見込みです。  
 民生関係については、省エネ規制の強化によるルームエアコンの買い替え需要や、GX推進等に伴う通信機器の需要増により、緩やかに伸長していくと見ています。

電装分野では、電気自動車（EV）やハイブリッド車（HEV）ともに増加傾向が継続すると見ている一方、エンジン車は減少傾向が続く見通しです。

## 事業方針

成長分野への確実なスペックインと新規顧客の開拓  
SiCの需要拡大に合わせた生産体制の構築

## 重点施策

### ■ 売上拡大と新規スペックインの強化

- 産業分野：モータードライブ、再エネ分野を中心に拡販
- 電装分野：新規顧客開拓と確実なスペックイン

### ■ 競争力のある新製品開発

- 次世代SiCモジュール、SiC 8インチ化
- 第8世代IGBTモジュール

### ■ ものづくりの強化

- 前工程： 需要に対応したSiCの生産能力増強と第8世代IGBTの量産対応  
小口径生産ラインの縮小
- 後工程： 新製品の量産立上げと需要増に対応した生産能力増強  
・産業向け第7、8世代IGBTモジュール、電装向けSiCモジュール（新製品）

こうした環境下における事業方針としては、成長分野での確実なスペックインと新規顧客の開拓、そしてSiCの需要拡大に合わせた生産体制の構築を進めてまいります。

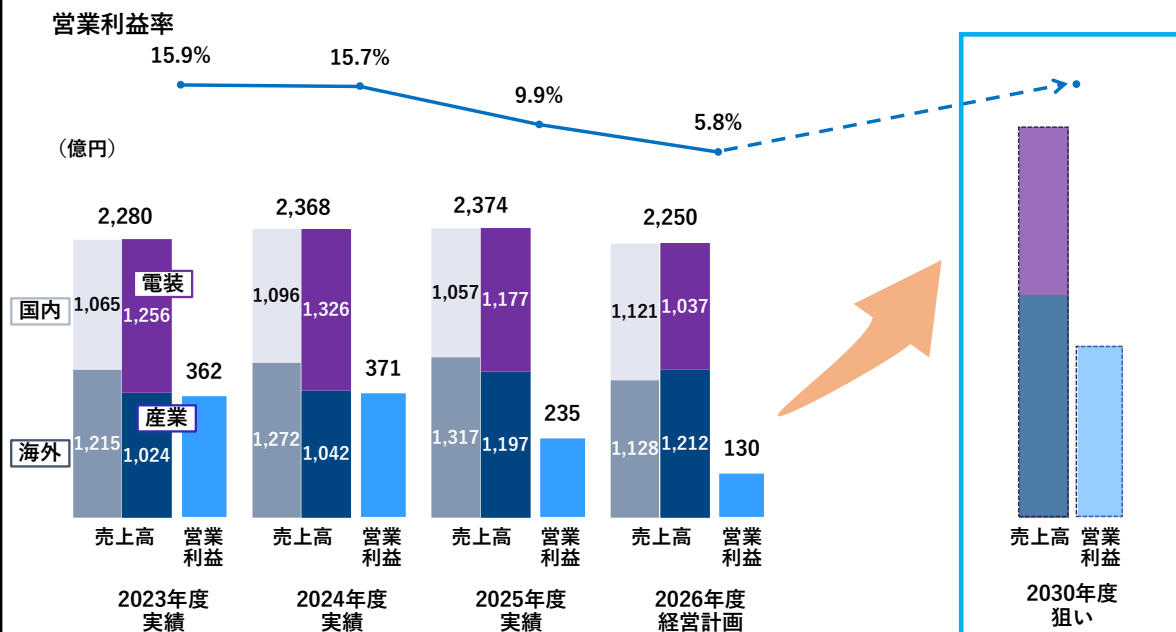
重点施策として、まず産業分野ではモータードライブや再エネ分野を中心に拡販を進め、電装分野では新規顧客の開拓と確実なスペックインにより売上拡大を図ります。

また、競争力のある新製品開発として、次世代SiCモジュールや、SiCの8インチ化、第8世代IGBTモジュールなどの開発に注力いたします。

モノづくりの強化については、前工程において、需要に対応したSiCの生産能力増強と、第8世代IGBTの量産対応を進めます。同時に、現在も保有している小口径の生産ラインについては縮小を進め、大口径化を図りながら生産性の改善に取り組みます。

後工程におきましては、新製品の量産立ち上げとして、産業向け第7・第8世代IGBTモジュール、および電装向けの新製品SiCモジュールの生産能力を増強します。

## 中長期的な業績拡大に向け、2026年度は成長準備フェーズ

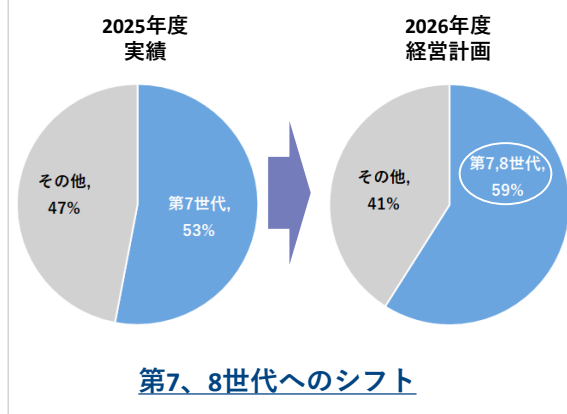


今年度、2026年度の経営計画は、売上高2,250億円、営業利益130億円と、減収減益の計画となります。

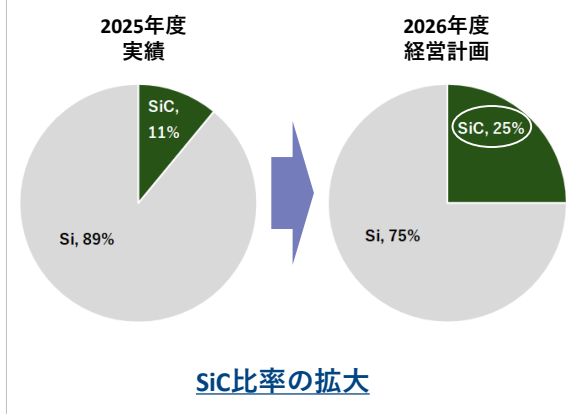
今年度は、次期中期計画に向けて売上・利益を再び拡大させていくための「成長準備のフェーズ」と位置づけ、しっかりと基盤を整えてまいります。

- 産業モジュール：第7、8世代IGBTの売上比率は約60%となる見通し
- 電装モジュール：SiC売上比率は25%へ拡大

産業モジュール売上構成比率



電装モジュール売上構成比率

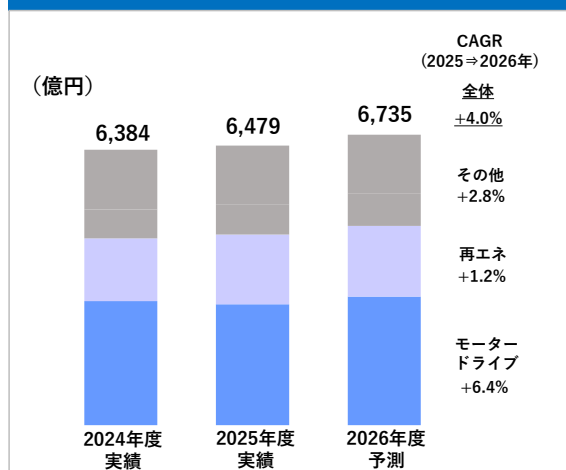


こちらは、産業用および電装用モジュールの売上構成比の推移です。左側の産業モジュールでは、現在最新である第7世代と、今年度から量産に入る第8世代を合わせて、今年度は構成比を約6割まで引き上げる計画です。さらに2030年に向けては、80%程度まで引き上げてまいりたいと考えております。

一方、右側の電装モジュールにおけるSiCの売上比率は、昨年度の11%に対し、今年度は25%まで高まる見込みです。こちらでも2030年に向けて、6割程度まで引き上げる計画で進めております。

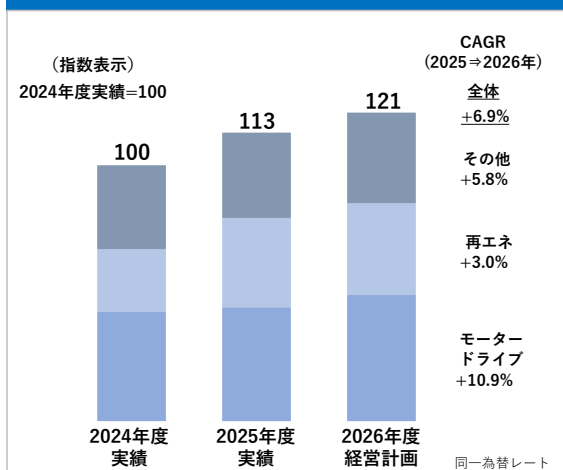
- 市場はモータードライブが牽引し全体で+4%の伸長を見込む
- 新製品拡販により市場伸長率以上に売上を拡大

当社対象 産業モジュール市場



出典元：調査会社DATAを基に弊社独自推定

産業モジュール売上推移



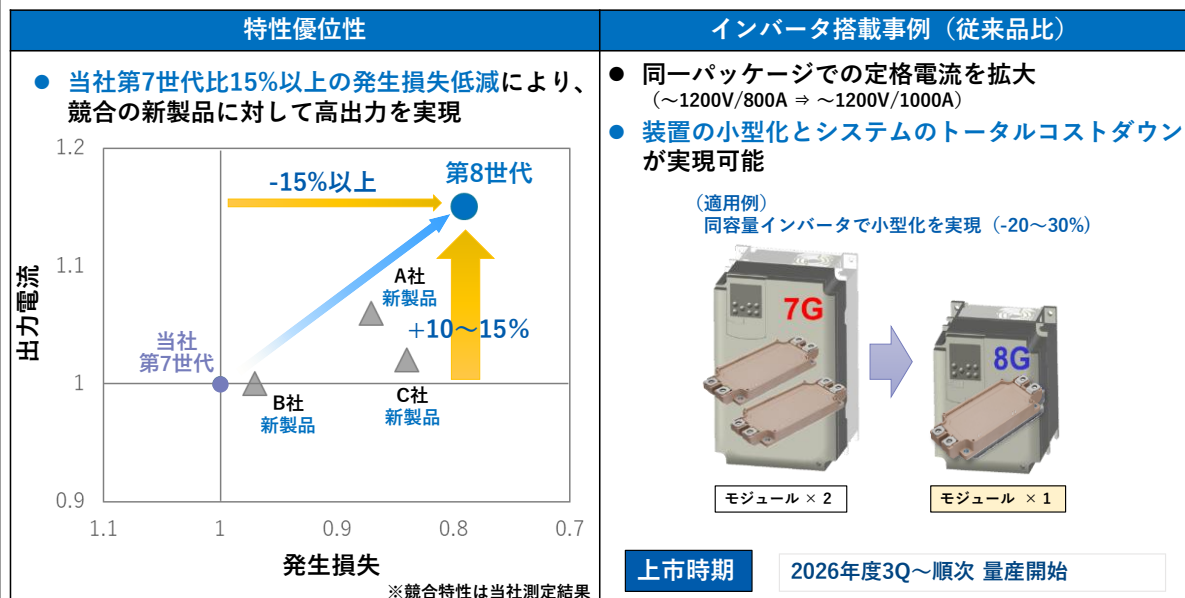
※ モータードライブ：インバータ、サーボ、NC工作機械、産業ロボット等  
※ その他：電鉄、民生、DC(電源、空調) 他

© Fuji Electric Co., Ltd. 13

スライド左側は産業モジュールの市場予測です。今年度の市場規模は6,735億円、前年比で約4%の伸びを予測しております。その中でも、しばらく低調だったモータードライブが6.4%増と、今年度は回復してくると推測しています。

右側の当社売上計画では、全体で前年比プラス6.9%を掲げており、市場の伸び以上の拡大を目指します。ここでも同様に、モータードライブで10.9%増と、この分野を牽引役として売上を拡大していく計画です。

- 性能向上（発生損失低減）により同一パッケージで定格電流を拡大
- 装置の小型化、システムコストダウンに貢献



産業向けの新製品開発としては、競争力のある新製品開発として、第8世代のIGBTモジュールの開発を進めております。

これは第7世代に対して15%以上の損失低減を図り、出力電流を10～15%程度向上させた製品です。これにより、同じパッケージサイズでありながら電流定格を拡大することができます。

従来はモジュールを2個使用していた装置が1個で済むようになるため、装置の小型化とシステムトータルでのコストダウンが可能となります。今年度の第3四半期から順次量産を開始する計画です。

## 再エネ、DC等の顧客装置に向け最適なモジュール製品で差別化

1200V/1700V定格	～600A	800A	1000A	1200A	1500A～ 1800A
既存 中容量 モジュール					
新製品 新中容量 モジュール					
既存 大容量 モジュール					

## 製品特長

- 中容量と大容量の中間領域に最適な新中容量モジュールを開発  
(当社独自パッケージ製品で差別化)
- フットプリントサイズ-25%小型化  
(大容量モジュール比)
- パッケージ内部の低インダクタンス化※  
( $\leq 10\text{nH}$ ) によりSiCチップ搭載にも対応

※インダクタンス：この値が大きくなるとスイッチング損失やノイズが増大

サンプル展開時期：2026年8月～

もう一つの新製品として、新しい「中容量モジュール」の開発も進めております。従来、再エネやデータセンター向けには既存の小容量・大容量モジュールをラインナップしてまいりましたが、ちょうどその中間の領域がパッケージとして不足しておりました。

この領域に当社独自のパッケージを投入してラインナップを拡充し、競合他社との差別化を図ります。

大容量モジュールと比較して占有面積を約25%小さくできる点や、内部インダクタンスを大幅に低減しているためSiCチップの搭載にも対応できる点がメリットです。

今年8月からサンプル展開を開始いたします。

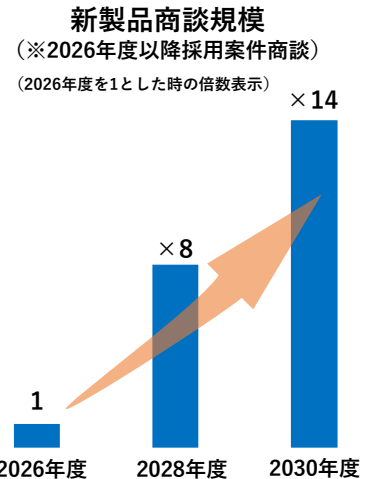
# 電装分野：スペックイン状況

- 新規顧客2社の商談を獲得
- 拡販活動を継続推進し、28年度以降の売上拡大を図る

## 電動車向け IGBT, SiCの新製品採用計画(2024年度以降採用案件)



★：2026年度以降採用案件



電装分野のスペックイン状況ですが、新しく2社からの商談を獲得いたしました。2028年以降に向けて、この2社を含めたスペックイン済みの案件を、確実に受注へと繋げてまいります。

右側のグラフは、2026年度以降の採用案件の商談規模を指数で示したものです。2026年の規模を「1」とした場合、2030年時点での商談規模は約14倍に達する見込みです。これらの高水準な案件を確実に獲得してまいります。

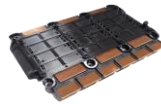


- 薄型パッケージの新製品をラインアップ化し新規顧客開拓を推進
- 顧客装置の小型化、低コスト化に貢献

SiCモジュール（高出力用）

- 立体配線技術により小型化・薄型化を実現
- SiCの高速スイッチング特性を活かすため、モジュール内部のインダクタンス\*を大幅低減

従来品比  
小型・薄型：-49%（体積比）  
低インダクタンス：-80%（ $L_{s24} \rightarrow 5nH$ ）



外形寸法：W167 x D111 x H16mm

インバータ出力	330kW
モジュール定格（1200V）	660A
適用クラス	大型車
	スポーツ車

上市時期 2026年度3Q～量産開始

SiCモジュール（次世代 薄型パッケージ）

- 同一パッケージで幅広い定格を系列化
- モジュールの組合せにより多様なインバータ回路構成に対応
- BOSCH社※と互換パッケージの提供により、お客様のマルチソース要求に対応



（適用例：2in1×3）

※Tier 1 メーカー（独） 外形寸法（カードサイズ）：W63 x D45 x H6mm

インバータ出力		100kW	200kW	300kW以上
モジュール定格（2in1×3）	1200V	200A	520A	~900A
	750V	490A	900A	---
適用クラス	小型車		中型車	大型車

サンプル展開：2026年度3Q～

そのために、電装向けSiCモジュールで競争力のある新製品を開発しています。

左側の高出力用モジュールは、今年の第3四半期から量産を開始いたします。これは「立体配線技術」という新技術を用いることで、従来品に比べ体積を約半分にまで小型・薄型化した製品です。SiCの高速スイッチングの特性を活かすため、内部インダクタンスも大幅に削減しています。

右側はさらに薄型のパッケージで、1つのパッケージで200アンペアから900アンペア程度までの幅広い電流定格をカバーするラインナップを展開します。モジュールの組み合わせによって多様なインバータ回路構成に対応できるほか、ドイツのボッシュ社と共通のパッケージ（互換パッケージ）とすることで、お客様のマルチソース化のニーズにも対応しております。こちらは今年の第3四半期からサンプル展開を開始いたします。

- 需要に対応したSiCの生産能力増強と量産対応、第8世代IGBTの生産開始
- Si 6インチ以下の小口径生産ライン縮小と8インチ化へのシフト  
(マレーシアの小口径ラインを25年度閉鎖、26年度8インチへ集約)



松本

### 前工程のマザー工場

- ・ SiC 6インチ生産開始 (2026年3Q~) 及び能力増強
- ・ SiC 8インチラインの量産準備
- ・ Si小口径ラインの縮小



山梨

### Si 8インチ生産

- ・ 電動車向けIGBT
- ・ 第8世代IGBT生産開始 (2026年2Q~)



津軽

### SiC 6インチ生産



マレーシア

### Si 8インチ生産

- ・ 産業向け第7世代IGBT

前工程における生産体制の施策です。

SiCにつきましては、昨年まで津軽工場で生産しておりましたが、今年度から松本工場でも6インチの生産を開始いたします。同時に、松本工場ではSiC8インチ化への対応も進めてまいります。なお、既存の小口径Siラインが松本工場にあるため、こちらについては縮小を進めてまいります。

第8世代IGBTにつきましては、山梨工場にて、第2四半期からチップの量産に入る計画で進めております。

## 新製品の量産立上げと需要増に対応した生産能力増強



国内（3拠点）

### 組立製品のマザー工場 国内顧客向け製品の生産拠点

- ・ 電動車向け小型IGBTモジュール増産及びSiCモジュール生産開始（2026年3Q～）
- ・ 産業用大容量モジュールの能力増強（前年度比 約3倍）
- ・ 第8世代IGBTモジュール生産開始（2026年度3Q～）



フィリピン

### ディスクリート製品及びエアコン向けモジュールの主力拠点



中国（深セン）

### 中国顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点

- ・ 第7世代IGBTモジュールの能力増強（需要増対応、前年度比 約30%増）

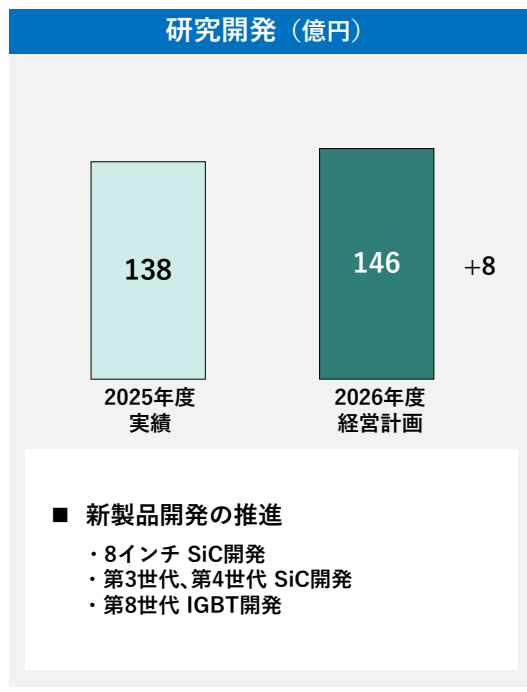
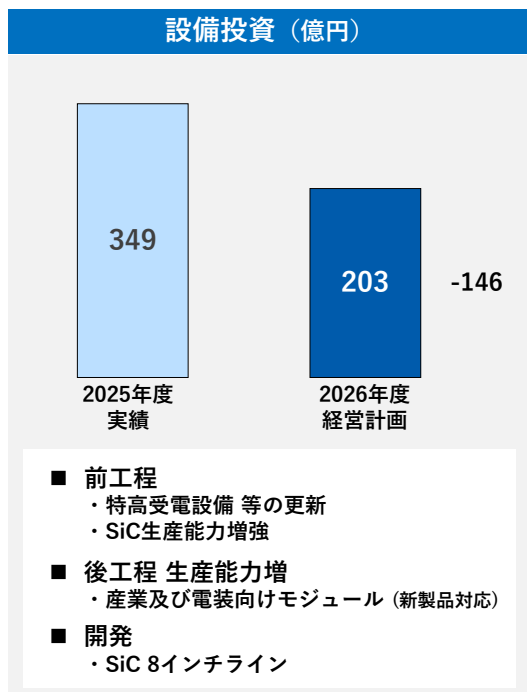


マレーシア

### 欧米顧客向け産業IGBTモジュール生産拠点

- ・ 第7世代IGBTモジュールの能力増強（需要増対応、前年度比 約20%増）

後工程におきましては、国内拠点で電動車向けの新型SiCモジュール、および第8世代IGBTモジュールの生産を開始いたします。あわせて、中国やマレーシアの海外拠点において、第7世代IGBTモジュールの生産能力拡大を進めてまいります。



※研究開発費はテーマに応じてセグメントに分類したもので、決算短信記載の数値と異なります。

© Fuji Electric Co., Ltd. 20

最後に、今年度の設備投資と研究開発費についてです。  
今年度の設備投資計画は203億円で、前年度からは146億円の減少となります。

今年度の主な投資内容としては、特高の受電設備更新、SiCの生産能力増強、後工程モジュールの能力増強、および開発では8インチラインの整備などとなります。

研究開発費は146億円を計画しております。こちらはSiC8インチ化や、第3世代・第4世代SiCの開発、そして第8世代IGBTの開発などにかけていく方針です。

半導体事業からの説明は以上となります。

1. 本資料及び本説明会に含まれる予想値及び将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいております。その判断や仮定に内在する不確実性及び事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、その確実性を保証するものではありません。
2. 本資料は、情報の提供を目的とするものであり、弊社の株式の売買を勧誘するものではありません。
3. 目的を問わず、本資料を無断で引用または複製することを禁じます。